

03560.003025

#4 1/2

PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of

Susumu YASUDA, et al

Application No.: 10/073,304

Filed: February 13, 2002

For: TILTABLE-BODY APPARATUS,
AND METHOD OF
FABRICATING THE SAME

) Examiner: Unassigned

) Group Art Unit: 2872

) May 7, 2002



Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENTS

Sir:

In support of Applicants' claim for priority under 35 U.S.C. § 119, enclosed are
copies of the following Japanese applications:

2001-047295, filed February 22, 2001;

2001-047296, filed February 22, 2001;

2001-047297, filed February 22, 2001;

2001-279383, filed September 14, 2001;

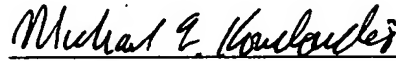
2001-278956, filed September 14, 2001; and

2001-301663, filed September 28, 2001.

RECEIVED
MAY - 8 2002
TECHNOLOGY CENTER 2800

Applicants' undersigned attorney may be reached in our Washington, D.C. office by telephone at (202) 530-1010. All correspondence should continue to be directed to our below-listed address.

Respectfully submitted,



Attorney for Applicants

Michael E. Kondoudis

Registration No. 42,758

FITZPATRICK, CELLA, HARPER & SCINTO
30 Rockefeller Plaza
New York, New York 10112-3801
Facsimile: (212) 218-2200

MEK/tmc

DC_MAIN 95717 v 1

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日
Date of Application 2001年 2月22日

出願番号
Application Number: 特願2001-047295

[ST.10/C]: [JP2001-047295]

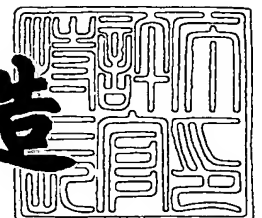
出願人
Applicant(s): キヤノン株式会社

RECEIVED
MAY -8 2002
TECHNOLOGY CENTER 2800

2002年 3月15日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2002-3016802

【書類名】 特許願

【整理番号】 4280130

【提出日】 平成13年 2月22日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G02B 26/10
G02B 27/17
G11B 21/10
G01L 3/10
B62D 5/04
B81B 3/00

【発明の名称】 マイクロ構造体、マイクロ力学量センサ、マイクロアクチュエータ、マイクロ光偏向器、光走査型ディスプレイ、及びそれらの製造方法

【請求項の数】 25

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社
社内

【氏名】 安田 進

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社
社内

【氏名】 八木 隆行

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社
社内

【氏名】 加藤 貴久

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社
社内

【氏名】 廣瀬 太

【特許出願人】

【識別番号】 000001007

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代表者】 御手洗 富士夫

【代理人】

【識別番号】 100086483

【弁理士】

【氏名又は名称】 加藤 一男

【電話番号】 0471-91-6934

【手数料の表示】

【納付方法】 予納

【予納台帳番号】 012036

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9704371

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 マイクロ構造体、マイクロ力学量センサ、マイクロアクチュエータ、マイクロ光偏向器、光走査型ディスプレイ、及びそれらの製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基板と、少なくとも一つ以上の揺動体を有し、前記揺動体が 1 本以上のトーションバーによって前記基板に対して弾性的に揺動自由に支持されているマイクロ構造体において、前記トーションバーは、横断面形状が略多角形であり、その少なくとも一つ以上の内角が 180 度よりも大きく、また、その材質が単結晶材料から成ることを特徴とするマイクロ構造体。

【請求項 2】 前記基板、揺動体、トーションバーが共通の単結晶材料基板から一体的に形成されていることを特徴とする請求項 1 に記載のマイクロ構造体。

【請求項 3】 前記単結晶材料がシリコン単結晶であることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載のマイクロ構造体。

【請求項 4】 前記単結晶材料が (100) 基板であり、トーションバーが異方性エッチングで形成されて、その外面を画する該 (100) 基板面に対する斜面が (111) 面であることを特徴とする請求項 3 に記載のマイクロ構造体。

【請求項 5】 前記基板或いは揺動体に繋がるトーションバーの付け根部の外面を画する該 (100) 基板面に対する面が (111) 面であることを特徴とする請求項 4 に記載のマイクロ構造体。

【請求項 6】 前記トーションバーの横断面形状が V 字状であることを特徴とする請求項 4 または 5 に記載のマイクロ構造体。

【請求項 7】 前記単結晶材料が平板状基板であり、トーションバーが深掘りエッチングで形成されて、その外面を画する面が該平板状基板面とこの面に対する垂直面或いは平行面から成ることを特徴とする請求項 1、2 または 3 に記載のマイクロ構造体。

【請求項 8】 前記トーションバーの横断面形状が V 字状、U 字状、T 字状、L 字状、或いは角張った S 字状であることを特徴とする請求項 1 乃至 7 の何れかに記載のマイクロ構造体。

【請求項 9】 前記トーションバーの角部が等方性エッチングで軽く丸くされて

、そこへの応力集中が緩和されていることを特徴とする請求項 1 乃至 8 の何れかに記載のマイクロ構造体。

【請求項 1 0】前記揺動体が一つであり、直線に沿って伸びた一つないし一对のトーションバーによって該揺動体が前記基板に対して弾性的に略該直線の回りに揺動自由に支持されていることを特徴とする請求項 1 乃至 9 の何れかに記載のマイクロ構造体。

【請求項 1 1】前記揺動体が複数であり、該複数の揺動体が入れ子式に配置され、各揺動体が、各直線に沿って伸びた一对のトーションバーによって、その外側の揺動体或いは前記基板に対して弾性的に略該各直線の回りに揺動自由に支持されていることを特徴とする請求項 1 乃至 9 の何れかに記載のマイクロ構造体。

【請求項 1 2】前記各直線が互いに角度を成して伸びていることを特徴とする請求項 1 1 に記載のマイクロ構造体。

【請求項 1 3】前記角度が 9 0 度であることを特徴とする請求項 1 2 に記載のマイクロ構造体。

【請求項 1 4】前記揺動体が複数であり、該複数の揺動体がトーションバーを介在させて直列的に配置され、最も外側の揺動体が前記基板にトーションバーを介在させて支持されていることを特徴とする請求項 1 乃至 9 の何れかに記載のマイクロ構造体。

【請求項 1 5】請求項 1 乃至 1 4 の何れかに記載のマイクロ構造体と、前記基板と前記揺動体の相対変位を検出する変位検出手段を有することを特徴とするマイクロ力学量センサ。

【請求項 1 6】請求項 1 乃至 1 4 の何れかに記載のマイクロ構造体と、前記揺動体を前記基板に対して相対的に駆動する駆動手段を有することを特徴とするマイクロアクチュエータ。

【請求項 1 7】前記駆動手段が、固定コアと、該固定コアを周回するコイルと、前記揺動体に接合された可動コアからなる電磁アクチュエータであることを特徴とする請求項 1 6 に記載のマイクロアクチュエータ。

【請求項 1 8】請求項 1 乃至 1 4 の何れかに記載のマイクロ構造体と、前記揺動体を前記基板に対して相対的に駆動する駆動手段と、前記揺動体に設けられた

光反射手段を有することを特徴とするマイクロ光偏向器。

【請求項 1 9】前記駆動手段が、固定コアと、該固定コアを周回するコイルと、前記揺動体に接合された可動コアからなる電磁アクチュエータであることを特徴とする請求項 1 8 に記載のマイクロ光偏向器。

【請求項 2 0】前記光反射手段が、光反射面或いは回折格子であることを特徴とする請求項 1 8 または 1 9 に記載のマイクロ光偏向器。

【請求項 2 1】請求項 1 8 乃至 2 0 の何れかに記載のマイクロ光偏向器と、変調可能な光源と、前記光源の変調と前記マイクロ光偏向器の揺動体の動作を制御する制御手段を有することを特徴とする光走査型ディスプレイ。

【請求項 2 2】請求項 4 乃至 6 の何れかに記載のマイクロ構造体の製造方法であって、(1 0 0) 単結晶シリコン基板の両面にマスク層を成膜する工程と、前記両面のマスク層を前記揺動体とトーションバーの形態に応じてパターニングする工程と、前記(1 0 0) シリコン基板を異方性エッチングする工程を含むことを特徴とするマイクロ構造体の製造方法。

【請求項 2 3】前記異方性エッチングをアルカリ溶液を用いて行うことを特徴とする請求項 2 2 に記載のマイクロ構造体の製造方法。

【請求項 2 4】請求項 7 に記載のマイクロ構造体の製造方法であって、単結晶材料基板の両面にマスク層を成膜する工程と、前記両面のマスク層を前記揺動体とトーションバーの形態に応じてパターニングする工程と、前記基板を片面より深掘りエッチングする工程と、前記シリコン基板を他面より深掘りエッチングする工程を含むことを特徴とするマイクロ構造体の製造方法。

【請求項 2 5】前記トーションバーの角部を軽く等方性エッチングして、そこを丸くし、そこへの応力集中を緩和する工程を更に含むことを特徴とする請求項 2 2 乃至 2 4 の何れかに記載のマイクロ構造体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、マイクロマシンないしマイクロ構造体の分野に関するものである。より詳しくは、軸回りに揺動する部材を有するマイクロ力学量センサ、マイクロ

アクチュエータ、マイクロ光偏向器等に関するものである。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

機械要素を小型化しようとする、と、体積力よりも、表面力の占める割合が大きくなり、摩擦の影響が通常の大きさの機械よりも大きくなることは良く知られている。そのため、マイクロマシンの設計においては、摺動部や回転部を極力少なくするように考慮するのが一般的である。

【 0 0 0 3 】

軸回りに揺動する部材を有する光偏向器の従来例を説明する。図 2 2 は、米国特許第 4 3 1 7 6 1 1 号明細書に開示された光偏向器の斜視図を示している。図 2 3 は、その内部構造を説明するために、上記光偏向器を分解して表示した図である。また、図 2 4 と図 2 5 は、それぞれ、図 2 2 の切断線 1 0 0 3 と 1 0 0 6 におけるシリコン薄板 1 0 2 0 の断面図を示している。

【 0 0 0 4 】

上記光偏向器において、絶縁性材料からなる基板 1 0 1 0 には、凹み部 1 0 1 2 が形成されている。凹み部 1 0 1 2 の底部には、一对の駆動電極 1 0 1 4、1 0 1 6 およびミラー支持部 1 0 3 2 が配置されている。シリコン薄板 1 0 2 0 には、トーションバー 1 0 2 2、1 0 2 4 とミラー 1 0 3 0 が一体に形成されている。ミラー 1 0 3 0 は、表面に光の反射率の高い物質がコーティングされており、トーションバー 1 0 2 2、1 0 2 4 により揺動自由に支持されている。そして、シリコン薄板 1 0 2 0 は、駆動電極 1 0 1 4、1 0 1 6 と所定の間隔を保つように基板 1 0 1 0 上に対抗配置されている。

【 0 0 0 5 】

ここで、シリコン薄板 1 0 2 0 は、電氣的に接地されている。従って、駆動電極 1 0 1 4、1 0 1 6 に交互に電圧を印加することで、ミラー 1 0 3 0 に静電引力を作用させて、ミラー 1 0 3 0 をトーションバー 1 0 2 2、1 0 2 4 の長軸の回りに揺動させられる。

【 0 0 0 6 】

トーションバー 1 0 2 2、1 0 2 4 の断面形状は、図 2 5 に示すような台形で

ある。ところが、この様な断面形状のトーションバーを有するマイクロ構造体は、トーションバーが撓みやすいため、外部の振動を拾ってしまったり、トーションバーの軸がぶれてしまい、正確な駆動ができないという問題点があった。

【0007】

そのため、この様な光偏向器を光走査型ディスプレイに適用した場合に、外部振動によって像がぶれたり、スポット形状が変化してしまうという問題点があった。これは、光走査型ディスプレイを持ち運び容易な形態にした場合に、より大きな問題となる。

【0008】

そこで、トーションバーを撓みにくくするために、次のような構造が提案されている。図26は、10th International Conference on Solid-State Sensors and Actuators (Transducers '99) pp.1002-1005にて開示されたハードディスクヘッド用ジンバルである。このジンバルは、ハードディスクヘッド用サスペンションの先端に取り付けられ、磁気ヘッドにロールとピッチの動きを弾性的に許容させるためのものである。ジンバル2020は、内側にロールトーションバー2022、2024で回転自由に支持された支持棒2031を有している。また、支持棒2031の内側には、ピッチトーションバー2026、2028で回転自由に支持されたヘッド支持体2030が形成されている。ロールトーションバー2022、2024とピッチトーションバー2026、2028のねじれの軸（図26の直交する鎖線参照）は、互いに直交しており、それぞれ、ヘッド支持体2030のロールとピッチの動きを担当している。

【0009】

図27は、図26中の切断線2006における断面図である。図27に示すように、トーションバー2022の断面形状はT字形状をしており、また、ジンバル2020はリブを有する構造になっている。

【0010】

図28を用いて、本ジンバルの作製工程を説明する。まず、型取り用シリコンウエハー2091に、ICP-RIE（誘導結合プラズマ反応性イオンエッチング）のようなエッチング法を用いて、垂直エッチングを行う（a）。この型取り用シ

リコンウエハー 2 0 9 1 は、再利用が可能である。次に、型取り用シリコンウエハー 2 0 9 1 の上に、シリコン酸化膜とリン酸化ガラスからなる犠牲層 2 0 9 2 を成膜する (b)。続いて、構造体となるポリシリコン層 2 0 9 3 を成膜する (c)。そして、このポリシリコン層 2 0 9 3 のパターニングを行う (d)。最後に、犠牲層 2 0 9 2 を除去し、パターニングされたパッド 2 0 9 5 にエポキシ樹脂 2 0 9 4 でポリシリコン層 2 0 9 3 を接着する (e)。

【 0 0 1 1 】

この様にして作製された T 字断面を有するトーションバーは、円断面や長方形断面のような断面形状を有するトーションバーと比べて、断面二次極モーメント J が小さいわりに、断面二次モーメント I が大きいという特徴がある。そのため、比較的ねじれやすい割りに、撓みにくいトーションバーを提供できる。つまり、ねじれ方向に十分なコンプライアンスを確保しながら、ねじれの軸に垂直な方向には剛性の高いトーションバーを提供できる。

【 0 0 1 2 】

また、必要なコンプライアンスや許容ねじれ角を得るための長さが短いトーションバーを提供できるため、より小型化できるという利点もある。

【 0 0 1 3 】

こうして、この T 字断面を有するトーションバーを用いることで、ロール、ピッチ方向に十分なコンプライアンスを持ち、その他の方向には十分な剛性を有し、より小型化が可能なマイクロジンバルを提供できる。

【 0 0 1 4 】

【発明が解決しようとする課題】

しかし、このマイクロ構造体には、次のような問題点があった。

すなわち、ポリシリコンは、単結晶シリコンに比べて内部損失が大きいため、機械的な Q 値が低くなってしまう。そのため、機械的な共振を利用して駆動する際に、振動振幅を大きくできない。また、損失が大きいためエネルギー効率が低い。

【 0 0 1 5 】

本発明の目的は、この様な問題点を解決した、軸回りに揺動する部材を有する

マイクロ力学量センサ、マイクロアクチュエータ、マイクロ光偏向器等に適用できるマイクロマシンないしマイクロ構造体、その製造方法を提供することにある。

【 0 0 1 6 】

【課題を解決するための手段】

上記問題点を解決するための本発明のマイクロ構造体は、基板と、少なくとも一つ以上の揺動体を有し、前記揺動体が1本以上のトーションバーによって前記基板に対して弾性的に揺動自由に支持されているマイクロ構造体であって、前記トーションバーは、横断面形状が略多角形であり、その少なくとも一つ以上の内角が180度よりも大きく、また、その材質が単結晶材料から成ることを特徴とする。

【 0 0 1 7 】

この基本構成に基づいて、以下の如きより具体的な形態が可能である。

典型的には、前記基板、揺動体、トーションバーは、共通のシリコン単結晶、水晶などの単結晶材料基板からエッチングなどで一体的に形成され得る。

【 0 0 1 8 】

また、前記単結晶材料が(100)シリコン単結晶基板であり、トーションバーが異方性エッチングで形成されて、その外面を画する該(100)基板面に対する斜面が(111)面である様にできる。この際、前記基板或いは揺動体に繋がるトーションバーの付け根部の外面を画する(100)基板面に対する面も、(111)面である様にできる。(111)面は高精度且つ滑らかに形成されるので、作製されたトーションバーは破断し難いものとなる。更に、トーションバーの付け根部分の面も(111)斜面とすれば、ここへの応力集中が緩和できて、トーションバーの信頼性を高められる。

【 0 0 1 9 】

また、前記単結晶材料が平板状基板であり、トーションバーがICP-RIEなどを用いて深掘りエッチングで形成されて、その外面を画する面が該平板状基板面とこの面に対する垂直面或いは平行面から成る様にもできる。

【 0 0 2 0 】

少なくとも一つの内角が180度よりも大きい略多角形のトーションバーの横断面形状としては、V字状、U字状、T字状、L字状（図21（a）参照）、角張ったS字状（図21（b）参照）などの形状がある。V字状、U字状、T字状は後述の実施例ではほぼ左右対称になっているが、必要であれば、左右非対称な断面形状としてもよい。

【0021】

前記トーションバーの角部（急峻な楔部分など）が等方性エッチングで軽く丸くされて、そこへの応力集中が緩和されてもよい。

【0022】

マイクロ構造体の形態としては、前記揺動体が一つであり、直線に沿って伸びた一つないし一对のトーションバーによって該揺動体が前記基板に対して弾性的に略該直線の回りに揺動自由に支持されている形態を採り得る。一对のトーションバーの形態は後述の実施例に説明されているが、揺動体が充分軽量で一つトーションバーで支障なく揺動自由に支持され得る場合には、こうした形態も用途に応じて使用できる。

【0023】

他のマイクロ構造体の形態としては、前記揺動体が複数であり、該複数の揺動体が入れ子式に配置され、各揺動体が、各直線に沿って伸びた一对のトーションバーによって、その外側の揺動体或いは前記基板に対して弾性的に略該各直線の回りに揺動自由に支持されている形態も採り得る。2つの揺動体が入れ子式に配置された例は図26に示されている。必要であれば、3つ以上の揺動体が入れ子式に配置された形態も実現できる。前記各直線が互いに成す角度は、典型的には90度であるが（図26の例参照）、これも、必要であれば90度以外の角度であってよい。

【0024】

更なる他のマイクロ構造体の形態としては、前記揺動体が複数であり、該複数の揺動体がトーションバーを介在させて直列的に配置され、最も外側の揺動体が前記基板にトーションバーを介在させて支持されている形態も採り得る。例えば、比較的小質量の揺動体をトーションバーを介在させて比較的大質量の揺動体で

挟み、両側の大質量の揺動体をトーションバーを介在させて基板に繋げ、これら 3 つのトーションバーを一直線に沿って伸びる形態として、この形態において、大質量の揺動体の駆動で小質量の揺動体を間接的に駆動する。いずれにせよ、本発明のマイクロ構造体は、トーションバーの横断面形状が略多角形であり、その少なくとも一つ以上の内角が 180 度よりも大きく、また、その材質が単結晶材料であることに特徴があり、その形態は用途に応じて種々のものであり得る。

【0025】

更に、上記問題点を解決するための本発明のマイクロ力学量センサは、上記のマイクロ構造体と、基板と揺動体の相対変位を検出する変位検出手段を有することを特徴とする。変位検出手段としては、従来公知のものを使用して、例えば、静電容量の変化を電圧変化で検知して基板と揺動体の相対変位を検出するものがある。その具体例としては、特開平 8 - 1 4 5 7 1 7、特開 2 0 0 0 - 6 5 6 6 4、特開 2 0 0 0 - 2 9 2 4 3 4 号公報などに開示されている。

【0026】

更に、上記問題点を解決するための本発明のマイクロアクチュエータは、上記のマイクロ構造体と、前記揺動体を前記基板に対して相対的に駆動する駆動手段を有することを特徴とする。前記駆動手段としては、固定コアと、該固定コア（軟磁性体で形成される）を周回するコイルと、前記揺動体に接合された可動コア（軟磁性体或いは硬磁性体の永久磁石で形成されたりする。両者では駆動原理が異なり、前者では、軟磁性体の磁極は決まっておらず、固定コアに磁束が発生する時には磁気回路の磁束を切る軟磁性体の断面積の増す方向に磁束内へ軟磁性体が吸引される駆動力が起こり、磁束消滅時にはそれから解放されるのに対して、後者では、硬磁性体の磁極は決まっており、固定コアと可動コアの異或いは同磁極間の磁力（吸引力或いは反発力）が駆動力である）からなる電磁アクチュエータであったり、静電引力を利用するものであったりする。

【0027】

更に、上記問題点を解決するための本発明のマイクロ光偏向器は、上記のマイクロ構造体と、揺動体を基板に対して相対的に駆動する駆動手段と、前記揺動体に設けられた光反射手段を有することを特徴とする。駆動手段については、上で

述べた通りである。光反射手段としては、光反射面或いは回折格子があり、後者では1つのビームを複数のビーム（回折光）として偏向することもできる。

【0028】

更に、上記問題点を解決するための本発明の光走査型ディスプレイは、上記のマイクロ光偏向器と、変調可能な光源（半導体レーザなど）と、前記光源の変調と前記マイクロ光偏向器の揺動体の動作を制御する制御手段を有することを特徴とする。

【0029】

更に、上記問題点を解決するための本発明のマイクロ構造体の製造方法は、（100）単結晶シリコン基板の両面にマスク層を成膜する工程と、前記両面のマスク層を前記揺動体とトーシヨンバーの形態に応じてパターニングする工程と、前記（100）シリコン基板をアルカリ溶液などを用いて異方性エッチングする工程を含むことを特徴とする。

【0030】

更に、上記問題点を解決するための本発明のマイクロ構造体の他の製造方法は、単結晶シリコン基板などの単結晶材料基板の両面にマスク層を成膜する工程と、前記両面のマスク層を前記揺動体とトーシヨンバーの形態に応じてパターニングする工程と、前記単結晶材料基板を片面よりICP-RIEなどを用いて深掘りエッチングする工程と、前記単結晶材料基板を他面よりICP-RIEなどを用いて深掘りエッチングする工程を含むことを特徴とする。

【0031】

これらのマイクロ構造体の製造方法において、前記トーシヨンバーの角部を軽く等方性エッチングして、そこを丸くし、そこへの応力集中を緩和してもよい。

【0032】

【作用】

本発明のマイクロ構造体の作用について説明する。

本発明のマイクロ構造体においては、上述したように、単結晶材料から成るトーシヨンバーの断面形状を略多角形とし、その一つ以上の内角が180より大きい形状としている。図21は、本発明のトーシヨンバーの断面形状の例を示して

いる。(a)は、1つの内角が 270° 、5つの内角が 90° の六角形形状を示している。また、(b)は、2つの内角が 270° 、6つの内角が 90° の八角形形状を示している。

【0033】

トーションバーの断面形状をこの様にすることで、比較的ねじれやすく、ねじれの軸に角度を成す方向に対して撓みにくい構造を実現することができる。なぜなら、こうした方向に撓ませようとしても、材料が比較的厚い部分があって該厚い部分が撓みを阻止しようとするからである。加えて、素材として単結晶材料を使用することで、機械的なQ値の高い構造を実現することができる。単結晶材料としては、入手の容易で機械特性に優れた(すなわち、比較的軽量でありながら物理的強度、耐性、寿命に優れた)単結晶シリコンを使用するのが好適である。

【0034】

【発明の実施の形態】

以下に、本発明の実施の形態を明らかにすべく、図面を参照しつつ実施例を説明する。

【0035】

[実施例1]

図1は、本発明の実施例1のマイクロ光偏向器を説明するための斜視図である。図2は、内部構造を説明するために、上記マイクロ光偏向器を分解して示した図である。図3は、本実施例のマイクロ光偏向器の動作を説明するための断面図である。図4は、本実施例の特徴であるトーションバーの構造を説明するための断面図であり、図1の切断線106におけるシリコン単結晶薄板120の断面を示している。

【0036】

実施例1のマイクロ光偏向器において、ガラス基板110には、凹み部112が形成されている。凹み部112の底部には、一对の駆動電極114、116および三角柱状のミラー支持部132が配置されている。ミラー支持部132は、可能であれば、無くしてもよい。シリコン単結晶薄板120には、バルクマイク

ロマシニング技術により、トーションバー 1 2 8、1 2 9 とミラー 1 3 0 が、一体に形成されている。本実施例の特徴であるトーションバー 1 2 8、1 2 9 は、図 4 に示すように、断面形状が左右対称な V 字形状になっている。これは、一つの内角が 2 8 9. 4° の 7 角形である。

【 0 0 3 7 】

ミラー 1 3 0 は、平板の表面に光の反射率の高い物質がコーティングされて形成されており、V 字形状のトーションバー 1 2 8、1 2 9 によりこの長軸の回りに揺動自由に支持されている。そして、シリコン単結晶薄板 1 2 0 は、ミラー 1 3 0 が駆動電極 1 1 4、1 1 6 と所定の間隔を保つようにガラス基板 1 1 0 上に対抗配置されている（図 3）。トーションバー 1 2 8、1 2 9 の長軸に沿ったミラー 1 3 0 の下面は図 3 に示す様にミラー支持部 1 3 2 の頂線部に接していて、該頂線部に沿う揺動軸の回りでミラー 1 3 0 が揺動可能になっている。

【 0 0 3 8 】

シリコン単結晶薄板 1 2 0 は、電氣的に接地されている。従って、駆動電極 1 1 4、1 1 6 に交互に電圧を印加することで、ミラー 1 3 0 に静電引力を作用させて上記揺動軸の回りにミラー 1 3 0 を揺動させることができる。駆動力は静電引力に限らず、磁気力などを使うこともできる。この場合は、駆動電極の代わりに電磁石を設置してミラー 1 3 0 の下面に硬磁性材料の磁石を固定するなどの構成をとることになる。

【 0 0 3 9 】

上記光偏向器の作製法について、図 6 と図 7 を用いて、以下に詳しく述べる。図 6 (a) ~ (e) は図 1 の切断線 1 0 6 における断面を表し、図 7 (a) ~ (e) は、図 2 の切断線 1 0 9 における断面を表している。

【 0 0 4 0 】

まず、図 6 に沿ってシリコン単結晶薄板 1 2 0 の加工について述べる。

【 0 0 4 1 】

1. シリコン単結晶薄板 1 2 0 の両面に、マスク層 1 5 0（例えば、 SiO_2 や低圧化学気相成長法で作製した窒化シリコン等）を成膜する。シリコン単結晶薄板 1 2 0 には、(1 0 0) 基板を使用する。そして、フォトリソグラフィ技術で、

マスク層 1 5 0 のパターニングを行う (a)。図 6 中、基板 1 2 0 上面側、下面側には、それぞれ、幅 W_a の一つの開口と幅 W_b の二つの開口が形成される。幅 W_b の二つの開口の間のストライプ状のマスク層 1 5 0 は、幅 W_a の開口の中心線に対応して伸びている。幅 W_a は V 字形状のトーションバー 1 2 8、1 2 9 の最上部開口の幅にほぼ設定され、幅 W_b の二つの開口の間のストライプ状のマスク層 1 5 0 の幅は V 字形状のトーションバー 1 2 8、1 2 9 の最底部の幅にほぼ設定される。

【 0 0 4 2 】

2. KOH のようなアルカリ溶液である異方性エッチング溶液を用いて、シリコン単結晶薄板 1 2 0 の両面からエッチングを行う。シリコンの異方性エッチングは、(1 0 0) 面で速く進み、(1 1 1) 面で遅く進むため、エッチングは、まず、掘り進むにつれて開口部が狭くなるように進行する (b、c)。このとき、エッチング部の側面は滑らかな (1 1 1) 面となる。

【 0 0 4 3 】

3. W_b の幅を有する開口部においては、基板 1 2 0 を貫通するまでエッチングが進行するが、 W_a の幅を有する開口部においては、基板 1 2 0 を貫通する手前でエッチングが止り V 字形状のトーションバー 1 2 8、1 2 9 の底部が形成される (d)。図 5 に示すように、(1 1 1) 面は、(1 0 0) 面に対して、 54.7° の角度を有するため、開口部の幅 w と V 溝の深さ d の関係は、 $d = w/2 \cdot \tan 54.7^\circ$ である。従って、上記のように V 字形状のトーションバー 1 2 8、1 2 9 が形成される為に、 $W_a < 2t/\tan 54.7^\circ$ 、 $W_b > 2t/\tan 54.7^\circ$ の関係を満たしている。ここで、 t はシリコン単結晶薄板 1 2 0 の厚みである。

【 0 0 4 4 】

この様に、上面からのエッチングは、基板 1 2 0 の下面に達する前にすべての面が (1 1 1) 面になりエッチングがストップするため、V 字状の溝が形成される。下面からのエッチングは、基板 1 2 0 を貫通するまで進行し、マスク層 1 5 0 でストップする。

【 0 0 4 5 】

この際、ミラー 1 3 0 の回りの他のエッチング貫通部も形成されるように、下

面側のマスク層 1 5 0 のパターニングが行われている。また、(1 1 1) 面は高精度且つ滑らかに形成されるので、作製された V 字形状のトーションバー 1 2 8、1 2 9 は破断し難いものとなる。更に、上記異方性エッチングにより、トーションバー 1 2 8、1 2 9 の付け根部分の V 溝の面 (図 2 (a) に 1 2 8 a、1 2 9 a で示す) も図 2 (b) に示すように (1 1 1) 斜面となるので、ここへの応力集中が緩和できて、トーションバーの信頼性を高め、ミラーの光偏向角を大きくできる。

【0 0 4 6】

4. 上記異方性エッチング後、ガスや酸により等方性エッチングを行い、V 溝の急峻な楔部分やトーションバーの角部の角を丸くしてもよい。こうすれば、これらの部分への応力集中を緩和できる。

【0 0 4 7】

5. 次に、マスク層 1 5 0 を除去する (e)。

【0 0 4 8】

6. 最後に、ミラー 1 3 0 を洗浄し、表面に光反射膜を成膜する。

【0 0 4 9】

続いて、図 7 に沿ってガラス基板 1 1 0 の加工法について述べる。

1. ガラス基板 1 1 0 の両面にマスク層 1 5 1 (レジスト等) を成膜する (a)。

【0 0 5 0】

2. マスク層 1 5 1 をパターニングする (b)。三角柱状のミラー支持部 1 3 2 と凹み部 1 1 2 がエッチングで形成される様にパターニングする。

【0 0 5 1】

3. 凹み部 1 1 2 の深さが $25\mu\text{m}$ になるように、エッチングを行う (c)。このとき、三角柱状のミラー支持部 1 3 2 が形成される。

【0 0 5 2】

4. マスク層 1 5 1 を除去し、凹み部 1 1 2 に所定のパターンの駆動電極 1 1 4、1 1 6 を形成する (d)。

【0 0 5 3】

5. 図1に示すようなマイクロ光偏向器の形態になるように、シリコン単結晶薄板120とガラス基板110を接合する(e)。

【0054】

以上のように、本実施例の製造方法によれば、異方性エッチングを1度行うだけで、V字形状断面を有するトーションバー128、129を製造することができる。図4に示すように断面がV字形状になっている本実施例の光偏向器のトーションバー128(129)は、従来のT字形状断面のトーションバーと同様に、ねじれやすく、撓みにくい構造となっている。また、本実施例によれば、単結晶シリコンをトーションバーの素材に使用することで、ポリシリコンに比べて機械的なQ値が大きなマイクロ構造体を実現できる。

【0055】

更に、本実施例によれば、単結晶材料をトーションバーの素材に使用することで、より壊れにくく、より小型化が可能で、共振駆動したときに振動振幅が大きくエネルギー効率の高いマイクロ光偏向器を実現できる。また、本実施例の製造方法を用いることで、比較的容易に本実施例のマイクロ構造体を製造することができる。

【0056】

[実施例2]

図8は、本発明の実施例2の加速度センサを説明するための斜視図である。図9は、内部構造を説明するために、上記加速度センサを分解して示した図である。また、図10は、図8の切断線206における単結晶シリコン薄板220の断面を示している。

【0057】

本実施例の加速度センサにおいて、絶縁性基板210には、凹み部212が形成されている。凹み部212の底部には検出電極216が配置されている。シリコン薄板220には、一对のトーションバー228、229と可動部材230が、一体に形成されている。本実施例の特徴であるトーションバー228、229は、図10より分かるように、それぞれ、断面形状がU字形状になっている。これは、2つの内角が 270° 、6つの内角が 90° の8角形断面である。

【 0 0 5 8 】

可動部材 2 3 0 は、トーションバー 2 2 8、2 2 9 によりその長軸の回りに揺動自由に支持されている。そして、シリコン単結晶薄板 2 2 0 は、検出電極 2 1 6 と所定の間隔を保つように絶縁性基板 2 1 0 上に対抗配置されており、電氣的に接地されている。

【 0 0 5 9 】

以上の構成において、シリコン単結晶薄板 2 2 0 に対して垂直な方向に加速度が作用すると、可動部材 2 3 0 に慣性力が作用し、可動部材 2 3 0 は、トーションバー 2 2 8、2 2 9 の長軸の回りに回転変位する。可動部材 2 3 0 が回転変位すると、検出電極 2 1 6 との距離が変化するため、可動部材 2 3 0 と検出電極 2 1 6 の間の静電容量が変化する。そのため、検出電極 2 1 6 とシリコン単結晶薄板 2 2 0 の間の静電容量を従来周知の手段で検出することで、加速度を検出することができる。

【 0 0 6 0 】

また逆に、検出電極 2 1 6 に電圧を印加すると、可動部材 2 3 0 と検出電極 2 1 6 の間に静電引力が作用し、可動部材 2 3 0 はトーションバー 2 2 8、2 2 9 の長軸の回りに揺動する。つまり、本実施例の加速度センサは、静電アクチュエータとしても使用することができる。

【 0 0 6 1 】

上記加速度センサの作製法について、図 1 1 と図 1 2 を用いて、以下に詳しく述べる。図 1 1 (a) ~ (e) は図 8 の切断線 2 0 6 における断面を表し、図 1 2 (a) ~ (e) は図 9 の切断線 2 0 9 における断面を表している。

【 0 0 6 2 】

先ず、図 1 1 に沿って単結晶シリコン薄板 2 2 0 の加工法を述べる。

1. シリコン薄板 2 2 0 の両面に、マスク層 2 5 0 (例えば、レジスト等) を成膜し、図 9 に示すような形態のシリコン薄板 2 2 0 をエッチングで形成できるようなパターニングをフォトリソグラフィ技術で行う (a)。ここでは、シリコン薄板 2 2 0 の面方位は問わない。

【 0 0 6 3 】

2. ICP-RIEのような深堀エッチング法を用いて、U字形状のトーションバー 2 2 8、2 2 9 と可動部材 2 3 0 と枠部以外のシリコン薄板部分を下面より一定の深さまで垂直エッチングを行う (b)。この深さは、断面がU字形状のトーションバー 2 2 8、2 2 9 の厚さを規定するものである。

【0 0 6 4】

3. 次に、ICP-RIEのようなエッチング法を用いて、上面より垂直エッチングを行う。エッチングは、U字形状のトーションバー 2 2 8、2 2 9 と可動部材 2 3 0 と枠部以外の部分のシリコン薄板 2 2 0 を貫通するまで行う (c、d)。トーションバー 2 2 8、2 2 9 の部分では、U字形状のトーションバー 2 2 8、2 2 9 の所定の厚さの底部を残した所で止る。U字形状のトーションバー 2 2 8、2 2 9 の両側部の厚さ (典型的には底部の厚さと等しい) は上面のマスク層 2 5 0 の一対のストライプ部の幅で規定される。

【0 0 6 5】

4. 最後に、マスク層 2 5 0 を除去する (e)。

【0 0 6 6】

次に、図 1 2 に沿って絶縁性基板 2 1 0 の加工法を述べる。

1. 絶縁性基板 2 1 0 の両面にマスク層 2 5 2 (レジスト等) を成膜する (a)。

【0 0 6 7】

2. 図 9 に示すような形態の絶縁性基板 2 1 0 をエッチングで形成できるようにマスク層 2 5 2 をパターンニングする (b)。

【0 0 6 8】

3. 凹み部 2 1 2 の深さが $1.5 \mu\text{m}$ になるように、エッチングを行い、凹み部 2 1 2 を形成する (c)。

【0 0 6 9】

4. マスク層 2 5 2 を除去し、凹み部 2 1 2 に検出電極 2 1 6 を蒸着などで形成する (d)。

【0 0 7 0】

5. 図 8 に示すような加速度センサの形態になるように、シリコン薄板 2 2 0

とガラス基板 2 1 0 を接合する (e)。

【 0 0 7 1 】

本実施例の特徴である断面形状が U 字形状の単結晶材料のトーションバーにおいても、ねじれやすく、撓みにくい構造となっている。また、従来よりも機械的な Q 値が高く、感度の高い力学量センサを提供することができる。更に、従来よりも機械的な Q 値が高いため、共振駆動を行なったときに振幅を大きくすることができ、また、エネルギー効率の高いマイクロアクチュエータを提供できる。

【 0 0 7 2 】

[実施例 3]

図 1 3 は、本発明の実施例 3 のマイクロ光偏向器を説明するための斜視図を示している。図 1 4 と図 1 5 は、それぞれ上面図と側面図である。図 1 5 においては、分かりやすくするために、シリコン単結晶薄板 3 2 0 の一部を切断して示している。図 1 6 は、本実施例の特徴であるトーションバーの構造を説明するための、図 1 3 の切断線 3 0 6 におけるシリコン単結晶薄板 3 2 0 の断面図を示している。

【 0 0 7 3 】

本実施例のマイクロ光偏向器において、シリコン単結晶薄板 3 2 0 には、バルクマイクロマシニング技術により、トーションバー 3 2 8、3 2 9 とミラー 3 3 0 が、一体に形成されている。ミラー 3 3 0 の端には、軟磁性体材料からなる可動コア 3 4 1 が固定されている。本実施例の特徴であるトーションバー 3 2 8、3 2 9 は、図 1 6 の断面図に示すように、断面形状が逆 T 字形状となっている。これは、2 つの内角が 270° 、6 つの内角が 90° の 8 角形である。

【 0 0 7 4 】

ミラー 3 3 0 は、表面に光の反射率の高い物質がコーティングされており、トーションバー 3 2 8、3 2 9 によりその長軸であるねじり軸の回りに揺動自在に支持されている。

【 0 0 7 5 】

ガラス基板 3 4 0 の上には、図 1 4 で示す形状の軟磁性体材料からなる固定コア 3 4 2 が配置されており、この固定コア 3 4 2 をコイル 3 4 5 が周回している

。そして、シリコン単結晶薄板 3 2 0 とガラス基板 3 4 0 は、可動コア 3 4 1 と固定コア 3 4 2 のほぼ平行に対向する面が、所定の間隔を保つように接合されている。すなわち、ミラー 3 3 0 が揺動するときに、これら対向する面がほぼ平行状態を保ったままその重なり面積（可動コア 3 4 1 が、固定コア 3 4 2 に発生した磁束を切る断面積）が変化する様になっている。可動コア 3 4 1 と固定コア 3 4 2 で 2 つの間隙を含む閉じた直列磁気回路が形成される。

【 0 0 7 6 】

図 1 7 を用いて、本実施例の光偏向器の動作について説明する。

コイル 3 4 5 に通電すると、固定コア 3 4 2 が励磁される。図 1 7 では、固定コア 3 4 2 の図中手前側が N 極に、奥側が S 極に励磁されている様子を表している。すると、可動コア 3 4 1 は、上記対向面の重なり面積が増す方向（固定コア 3 4 2 で発生した磁束路に吸引される方向）、即ち図 1 7 の矢印の方向に引き付けられる。可動コア 3 4 1 と固定コア 3 4 2 は、図 1 5 に示すように、上記対向面の重なり面積が増加できる様に非通電時には高さが異なる状態で配置されているので、トーションバー 3 2 8、3 2 9 の回りに左回りの回転モーメントが生じる。ミラー 3 3 0 の共振周波数に合わせてコイル 3 4 5 への通電を ON / OFF すると、ミラー 3 3 0 がトーションバー 3 2 8、3 2 9 の回りに共振を起こす。この状態でミラー 3 3 0 に光線を入射することで、光の走査を行うことができる。

【 0 0 7 7 】

次に、本光偏向器の作製方法を説明する。

まず、図 1 8 を用いて、シリコン単結晶薄板 3 2 0 の加工方法を説明する。図中左側は、図 1 3 の切断線 3 0 6 における断面図であり、右側は、切断線 3 0 9 における断面図である。

【 0 0 7 8 】

1. 先ず、シリコン単結晶薄板 3 2 0 の片面に、種電極層 3 6 0 を成膜する。
(a)。

【 0 0 7 9 】

2. 種電極層 3 6 0 の上に、厚膜レジスト層 3 6 1（例えば、MicroChem社製 SU-8）を成膜し、フォトリソグラフィ技術で可動コア 3 4 1 形成用のパター

ニングを行う (b)。

【0080】

3. 軟磁性体層 3 6 2 を種電極層 3 6 0 の上に電解メッキで成膜する (c)。

【0081】

4. 厚膜レジスト層 3 6 1 及び種電極層 3 6 0 を除去する (d)。軟磁性体層 3 6 2 の下の種電極層 3 6 0 はそのまま残る。

【0082】

5. シリコン単結晶薄板 3 2 0 の両面に、マスク層 3 5 0 (例えば、レジスト等) を成膜し、図 1 3 に示す形態の単結晶薄板 3 2 0 形成用のパターニングをフォトリソグラフィ技術で行う (e)。

【0083】

6. ICP-RIE のようなエッチング法を用いて、下面より一定の深さまで垂直エッチングを行う (f)。この深さは、断面が逆 T 字形状のトーションバー 3 2 8、3 2 9 の底部の厚さを規定するものである。

【0084】

7. さらに、ICP-RIE のようなエッチング法を用いて、上面より垂直エッチングを行う。エッチングは、逆 T 字形状のトーションバー 3 2 8、3 2 9 とミラー 3 3 0 と枠部以外の部分のシリコン単結晶薄板 3 2 0 を、貫通するまで行う (g、h)。トーションバー 3 2 8、3 2 9 の部分では、逆 T 字形状のトーションバー 3 2 8、3 2 9 の所定の厚さの底部を残した所で止る。逆 T 字形状のトーションバー 3 2 8、3 2 9 の中央部の厚さ (典型的には底部の厚さと等しい) は上面のマスク層 3 5 0 のストライプ部の幅で規定される (h)。

【0085】

8. 最後に、マスク層 3 5 0 を除去する (i)。

【0086】

次に、図 1 9 を用いて、ガラス基板 3 4 0 の加工方法を説明する。図 1 9 は、図 1 3 の切断線 3 0 7 における断面図である。

【0087】

1. ガラス基板 3 4 0 の片面に種電極層 3 7 0 を成膜する (a)。

2. 種電極層 3 7 0 の上に厚膜レジスト層 3 7 1 を成膜し、固定コイル 3 4 2 形成用のパターニングを行う (b)。

3. 種電極層 3 7 0 の上に、コイル 3 4 5 の下配線層 3 7 2 を電解メッキで成膜する (c)。

4. 下配線層 3 7 2 部分以外の厚膜レジスト層 3 7 1 と種電極層 3 7 0 を除去する (d)。

5. 下配線層 3 7 2 の上に、絶縁層 3 7 3 を成膜し、両側部の配線層 3 8 2、3 8 3 形成用のパターニングを行う (e)。

【 0 0 8 8 】

6. 絶縁層 3 7 3 の上に、種電極層 3 7 4 を成膜する (f)。

7. 種電極層 3 7 4 の上に厚膜レジスト層 3 7 5 を成膜し、固定コア 3 4 2 である軟磁性体層 3 7 6 と両側部の配線層 3 8 2、3 8 3 を形成できる様にパターニングを行う (g)。

8. 厚膜レジスト層 3 7 5 の無い種電極層 3 7 4 の部分上に、軟磁性体層 3 7 6 と両側部の配線層 3 8 2、3 8 3 を電解メッキで成膜する (h)。

9. 厚膜レジスト層 3 7 5 と種電極層 3 7 4 を除去する (i)。

1 0. 再び絶縁層 3 7 7 を成膜し、上配線層 3 8 0 形成用のパターニングを行う (j)。このパターニングで、絶縁層 3 7 7 は両側部の配線層 3 8 2、3 8 3 の頂部の所のみ除かれている。

【 0 0 8 9 】

1 1. 絶縁層 3 7 7 の上に、種電極層 3 7 8 を成膜する (k)。

1 2. 種電極層 3 7 8 の上に厚膜レジスト層 3 7 9 を成膜し、パターニングを行う (l)。このパターニングで、厚膜レジスト層 3 7 9 は両側部の配線層 3 8 2、3 8 3 の外部の所のみ除かれている。

1 3. 種電極層 3 7 8 の上に、上配線層 3 8 0 を電解メッキで成膜する (m)。

1 4. 最後に、厚膜レジスト層 3 7 9 と種電極層 3 7 8 を除去する (n)。

最終的に、図 1 3 に示すような光偏向器の形態になるように、シリコン単結晶薄板 3 2 0 とガラス基板 3 4 0 を接合する。

【 0 0 9 0 】

本実施例の特徴である、図 1 6 のような断面形状のトーションバーにおいても、ねじれやすく、撓みにくいという特徴がある。また、本実施例の光偏向器も、従来よりも機械的なQ値が高いため、共振駆動を行ったときに、振幅が大きくエネルギー効率が低い。

【 0 0 9 1 】

[実施例 4]

図 2 0 は、実施例 4 の光走査型ディスプレイを説明する図である。X 光偏向器 4 0 1 と Y 光偏向器 4 0 2 は、実施例 3 の光偏向器と同様のものである。コントローラ 4 0 9 は、X 光偏向器 4 0 1 と Y 光偏向器 4 0 2 を制御して、レーザ光線 4 1 0 をラスタ状に走査し、表示する情報に応じてレーザ発振器 4 0 5 を変調することで、スクリーン 4 0 7 上に画像を 2 次元的に表示する。

【 0 0 9 2 】

本発明の光偏向器を光走査型ディスプレイに適用することで、エネルギー効率が低い光走査型ディスプレイを実現することができる。

【 0 0 9 3 】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、トーションバーの断面形状が略多角形であり、その少なくとも 1 つの内角が 1 8 0 度よりも大きく、また、その材質が単結晶材料であるので、ねじれやすく撓みにくいトーションバーを持ち機械的なQ値が大きなマイクロ構造体を提供することができる。また、機械的なQ値が高いため、ノイズが少なく、感度の高い、力学量センサを提供できる。また、機械的なQ値が高いため、共振駆動したときに振幅が大きく、また、エネルギー効率の高いマイクロアクチュエータを提供できる。また、機械的なQ値が高いため、共振駆動したときに振幅が大きく、また、エネルギー効率の高いマイクロ光偏向器を提供できる。

【 0 0 9 4 】

本発明の光偏向器を光走査型ディスプレイに適用することで、エネルギー効率が低い光走査型ディスプレイも提供できる。更に、本発明の製造方法を用いるこ

とで、本発明のマイクロ構造体、マイクロ光偏向器、マイクロ力学量センサ及びマイクロアクチュエータを比較的容易に製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の実施例 1 の光偏向器を説明するための斜視図である。

【図 2】

実施例 1 の光偏向器を説明するための分解図（a）、及びトーションバーの縦断面図（b）である。

【図 3】

実施例 1 の光偏向器を説明するための断面図である。

【図 4】

実施例 1 の光偏向器を説明するためのトーションバーの部分の横断面図である。

【図 5】

シリコンの異方性エッチングを説明する図である。

【図 6】

実施例 1 の光偏向器のシリコン単結晶薄板の作製プロセスを説明する図である。

【図 7】

実施例 1 の光偏向器のガラス基板の作製プロセスを説明する図である。

【図 8】

本発明の実施例 2 の加速度センサを説明するための斜視図である。

【図 9】

実施例 2 の加速度センサを説明するための分解図である。

【図 10】

実施例 2 の加速度センサを説明するためのトーションバーの部分の横断面図である。

【図 11】

実施例 2 の加速度センサのシリコン単結晶薄板の作製プロセスを説明する図で

ある。

【図 1 2】

実施例 2 の加速度センサのガラス基板の作製プロセスを説明する図である。

【図 1 3】

本発明の実施例 3 の光偏向器を説明する斜視図である。

【図 1 4】

実施例 3 の光偏向器を説明する上面図である。

【図 1 5】

実施例 3 の光偏向器を説明する一部破断した側面図である。

【図 1 6】

実施例 3 の光偏向器のトーションバーを説明する断面図である。

【図 1 7】

実施例 3 の光偏向器の動作原理を説明する図である。

【図 1 8】

実施例 3 の光偏向器のシリコン単結晶薄板の作製プロセスを説明する図である。

【図 1 9】

実施例 3 の光偏向器の固定コアとコイルの作製プロセスを説明する図である。

【図 2 0】

本発明の実施例 4 の光走査型ディスプレイを説明する図である。

【図 2 1】

本発明のトーションバーの例の断面形状を説明する図である。

【図 2 2】

従来の光偏向器を説明するための斜視図である。

【図 2 3】

従来の光偏向器を説明するための分解図である。

【図 2 4】

従来の光偏向器を説明するための断面図である。

【図 2 5】

従来の光偏向器を説明するためのトーションバーの部分の断面図である。

【図 2 6】

従来のハードディスク用ジンバルを説明する上面図である。

【図 2 7】

従来のハードディスク用ジンバルを説明するための断面図である。

【図 2 8】

従来のハードディスク用ジンバルの作製プロセスを説明する図である。

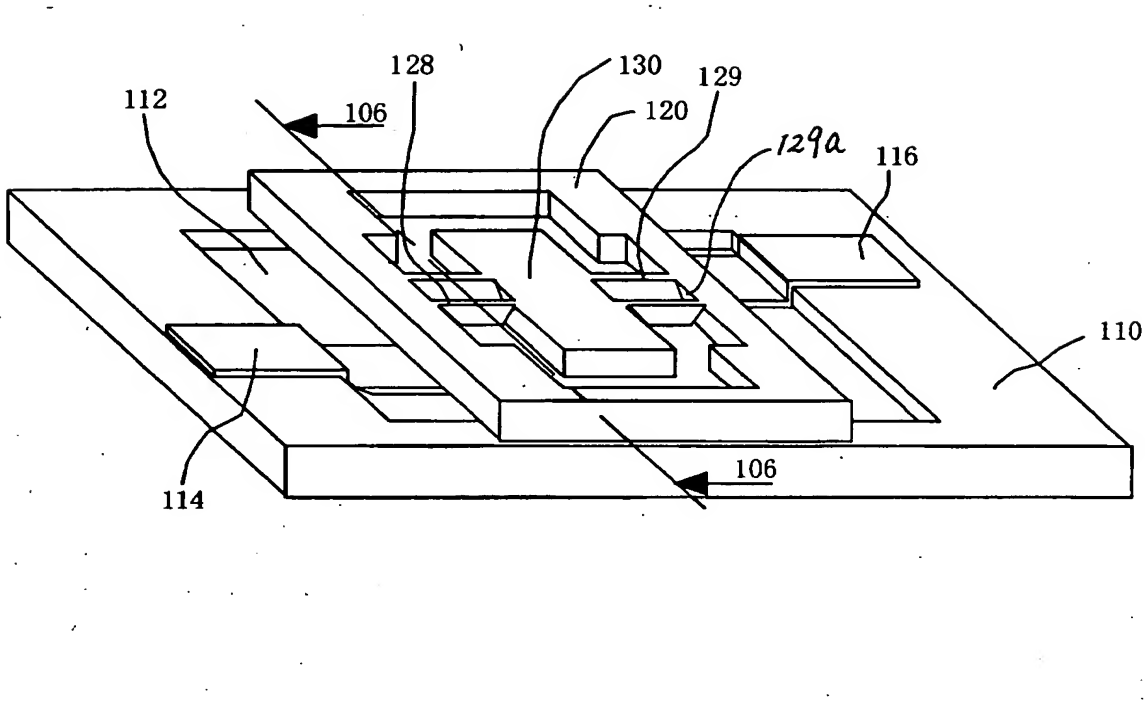
【符号の説明】

1 1 0、2 1 0、3 4 0	ガラス基板
1 1 2、2 1 2	凹み部
1 1 4、1 1 6	駆動電極
1 2 0、2 2 0、3 2 0	シリコン単結晶薄板
1 2 8、1 2 9、2 2 8、2 2 9、3 2 8、3 2 9	トーションバー
1 2 8 a、1 2 9 a	トーションバーの付け根部の斜面
1 3 0、3 3 0	ミラー
1 3 2	ミラー支持部
1 5 0、2 5 0、2 5 2、3 5 0	マスク層
2 1 6	検出電極
2 3 0	揺動部材
3 4 1	可動コア
3 4 2	固定コア
3 4 5	コイル
3 6 0、3 7 0、3 7 4、3 7 8	種電極層
3 6 2、3 7 6	軟磁性体層
3 6 1、3 7 1、3 7 5、3 7 9	厚膜レジスト層
3 7 2	下配線層
3 7 3、3 7 7	絶縁層
3 8 0	上配線層
3 8 2、3 8 3	側部配線層

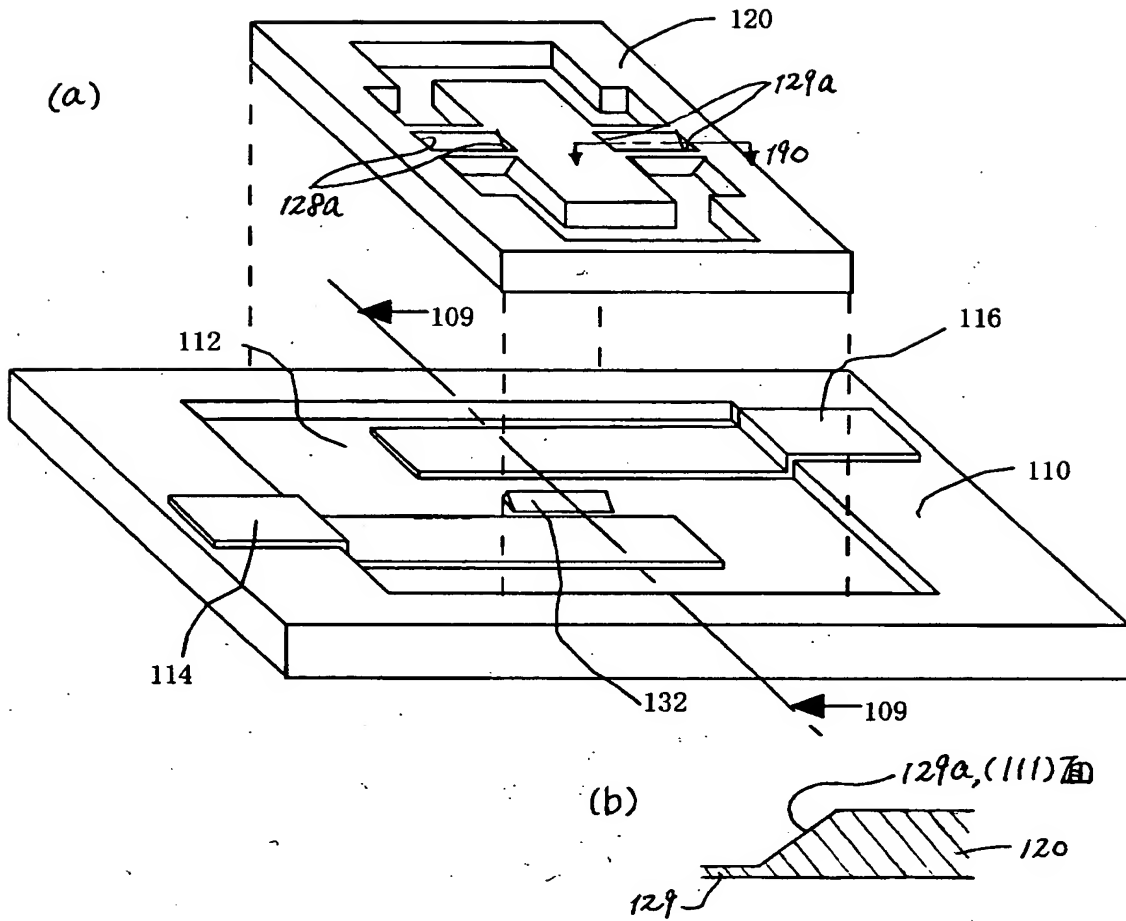
4 0 1	X 光偏向器
4 0 2	Y 光偏向器
4 0 5	レーザ発振器
4 0 7	スクリーン
4 0 9	コントローラ
4 1 0	レーザ光線
1 0 1 0	絶縁性基板
1 0 1 4、1 0 1 6	駆動電極
1 0 2 0	シリコン薄板
1 0 2 2、1 0 2 4、2 0 0 1、2 0 0 2	トーションバー
1 0 3 0、2 0 1 1	ミラー
1 0 3 2	ミラー支持部
2 0 2 0	ジンバル
2 0 2 2、2 0 2 4	ロールトーションバー
2 0 2 6、2 0 2 8	ピッチトーションバー
2 0 3 0	ヘッド支持体
2 0 3 1	支持枠
2 0 9 1	型取り用シリコンウェハー
2 0 9 2	犠牲層
2 0 9 3	ポリシリコン層
2 0 9 4	エポキシ樹脂
2 0 9 5	パッド

【書類名】 図面

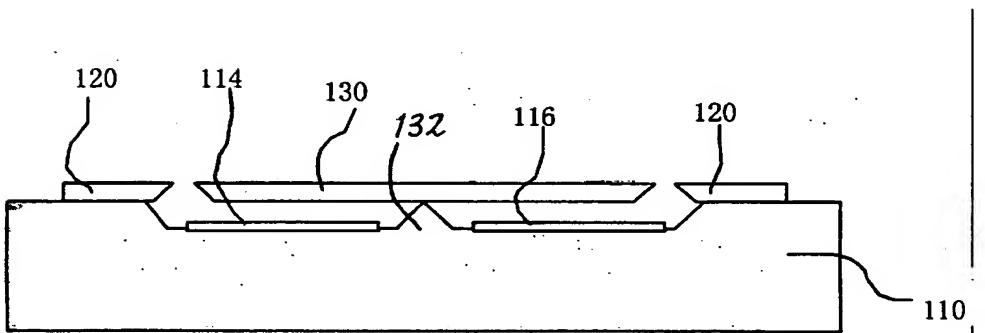
【図 1】



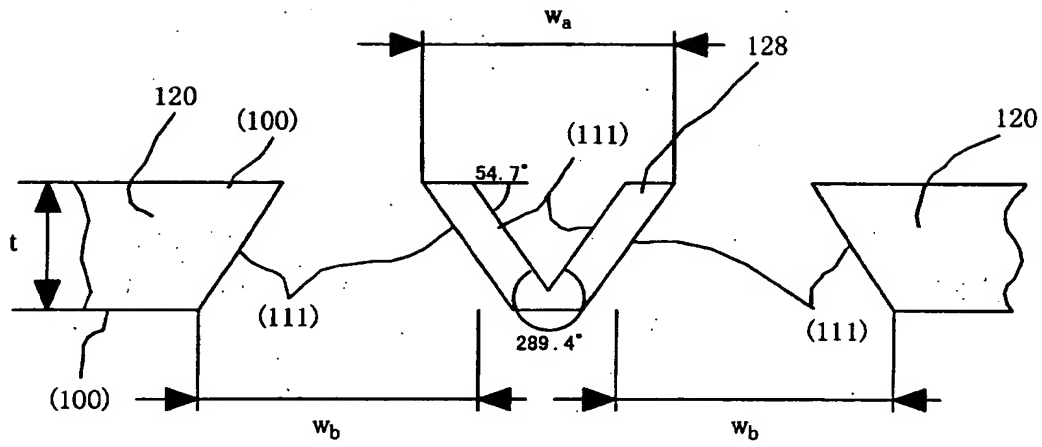
【図 2】



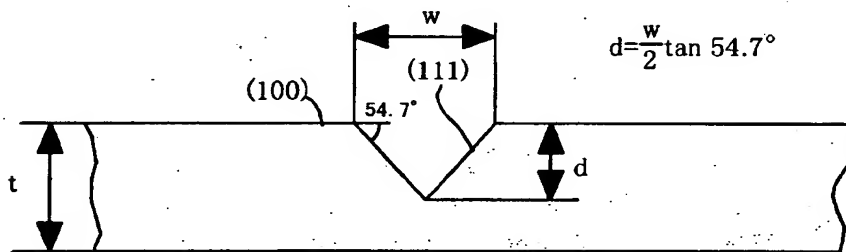
【図 3】



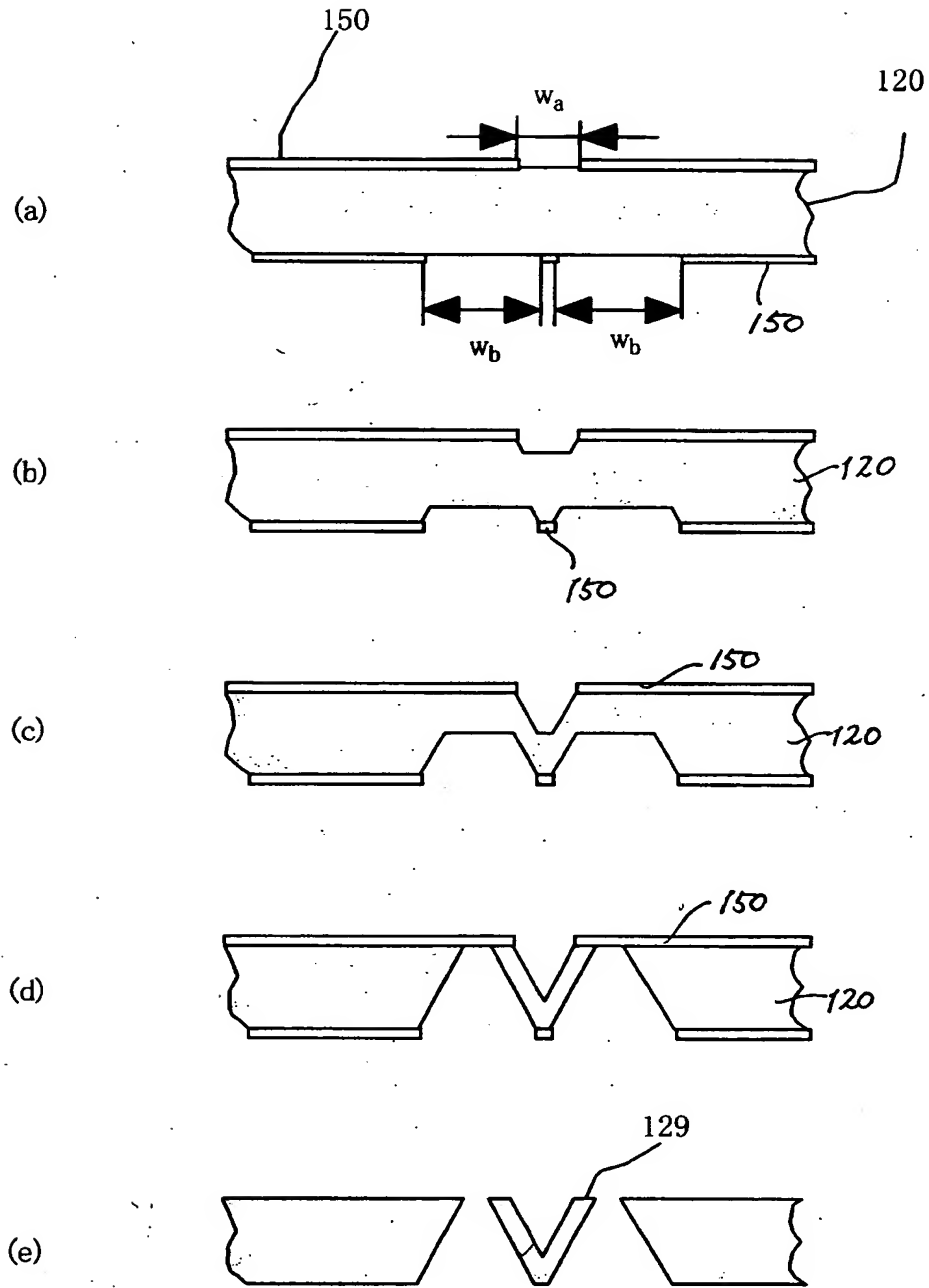
【図 4】



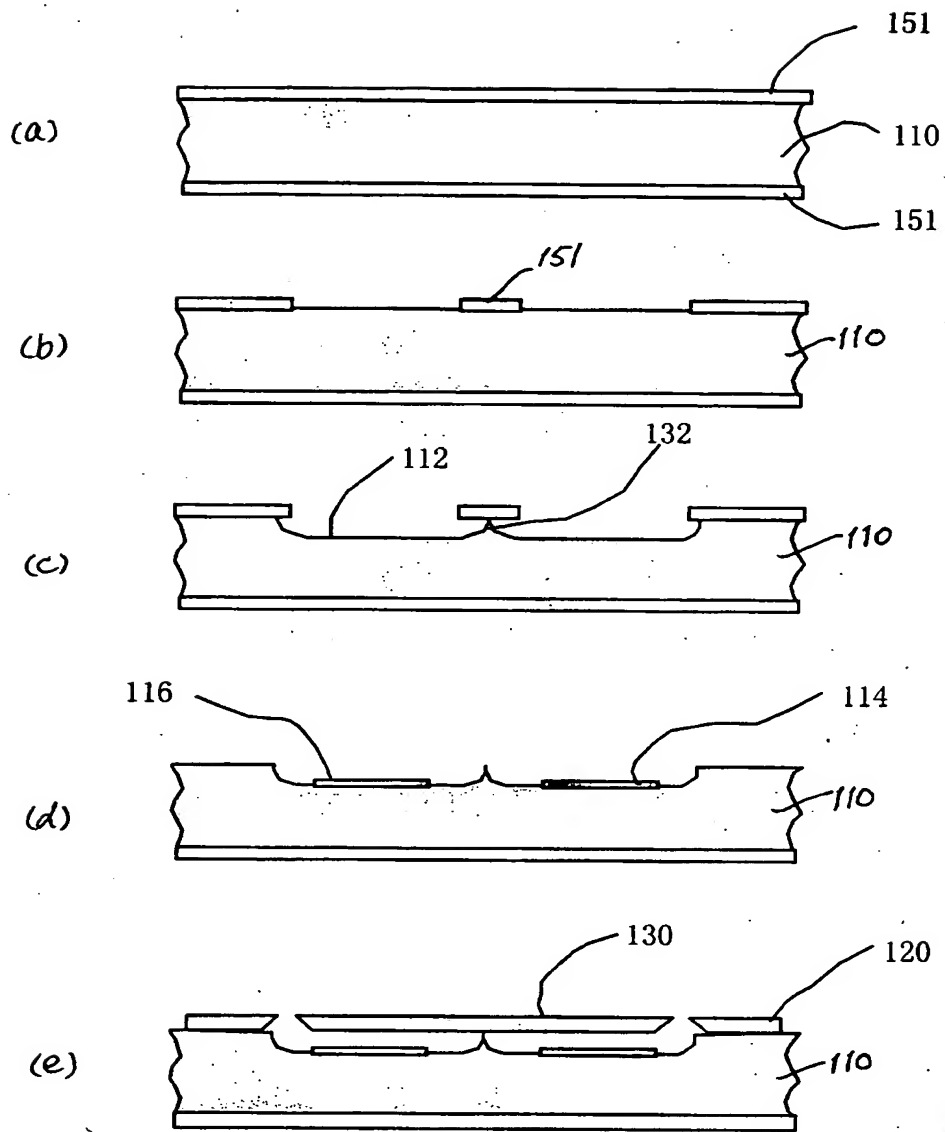
【図 5】



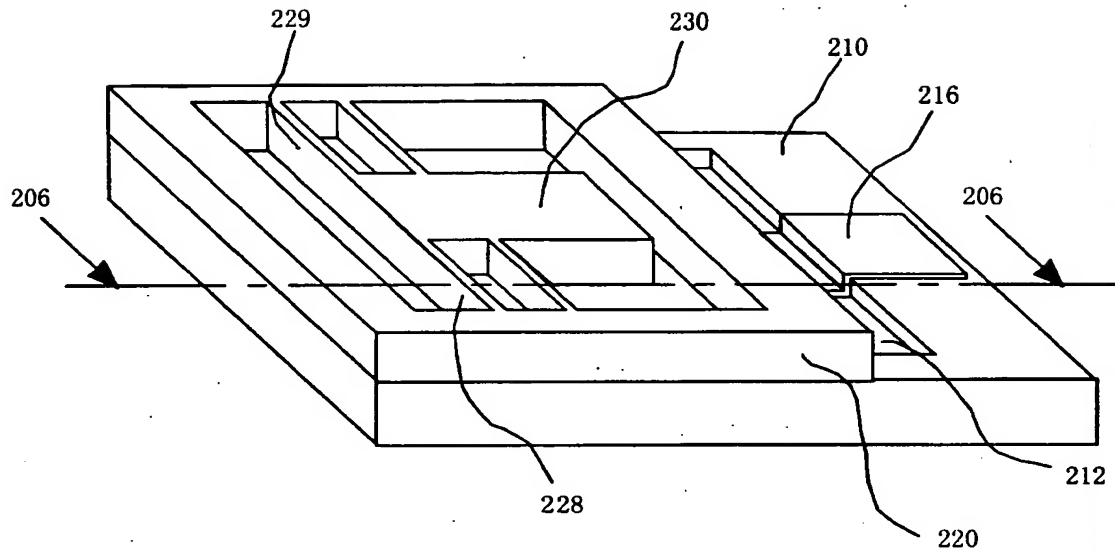
【図 6】



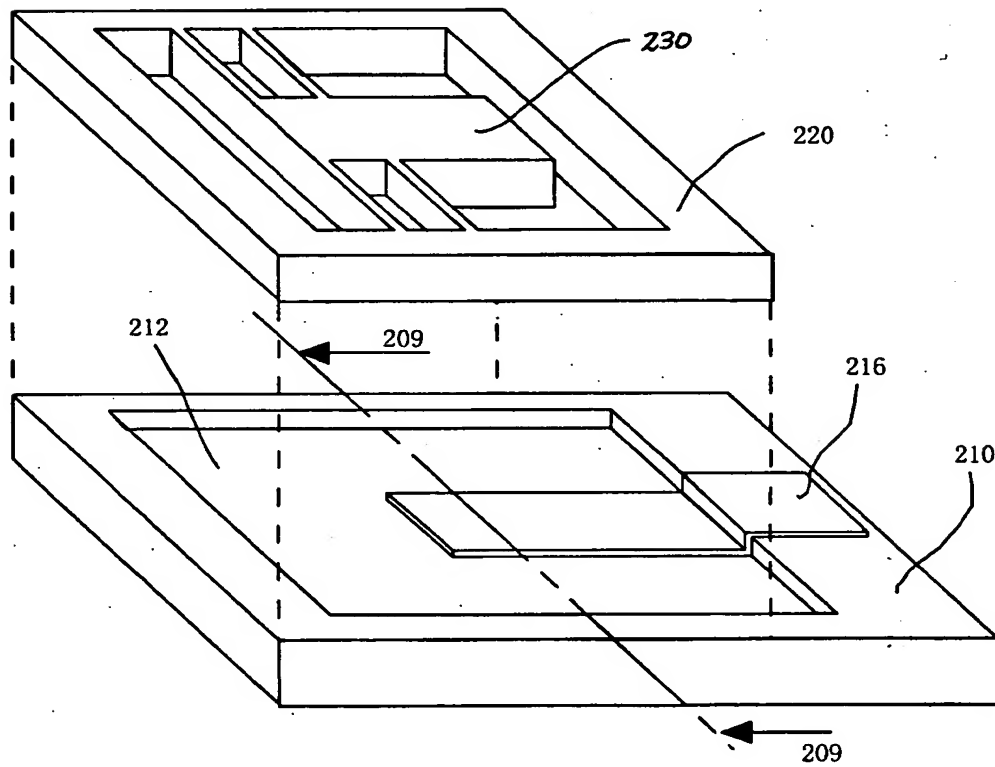
【図 7】



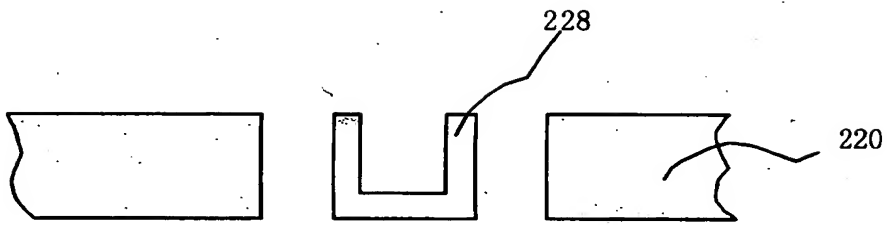
【図 8】



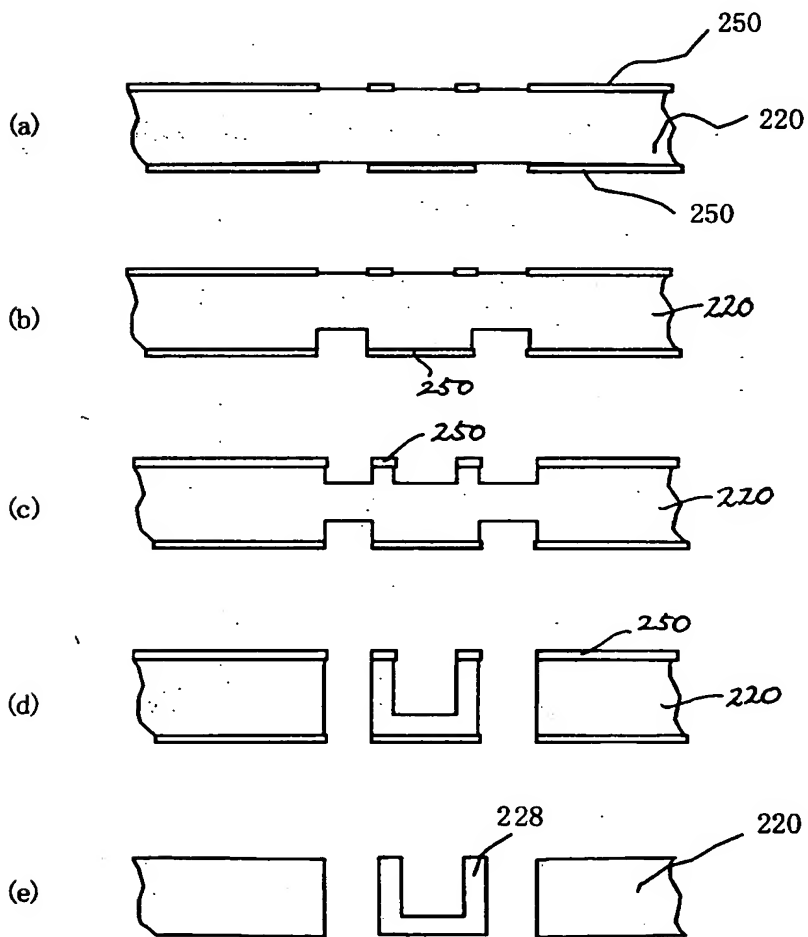
【図 9】



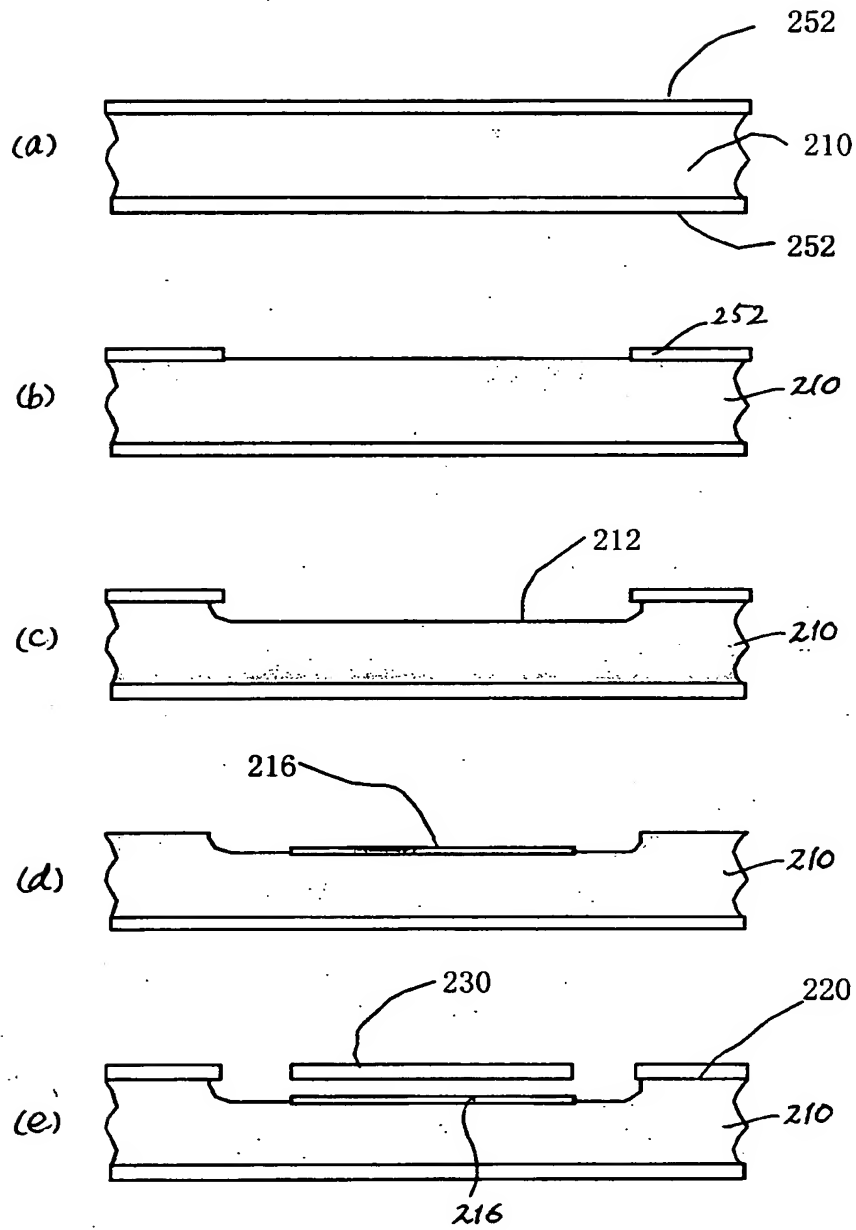
【図10】



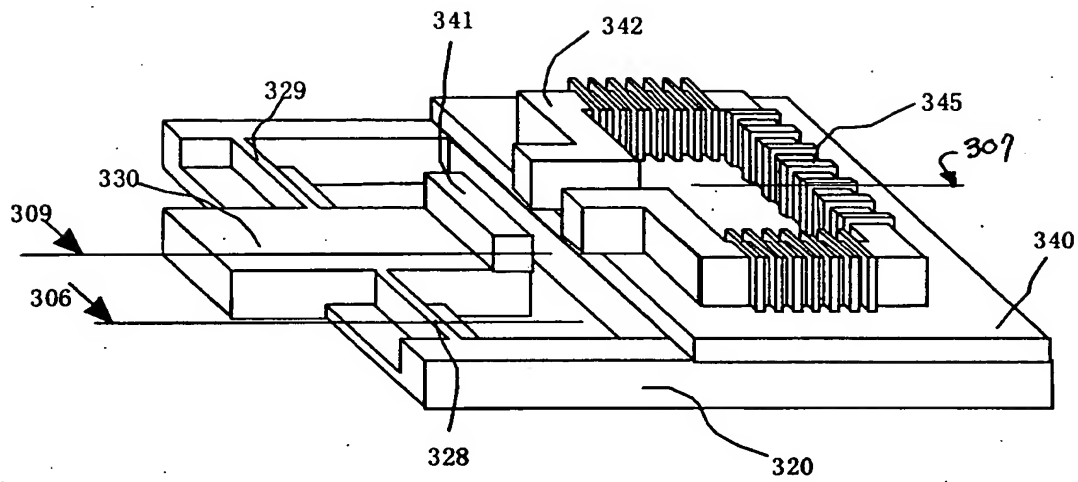
【図11】



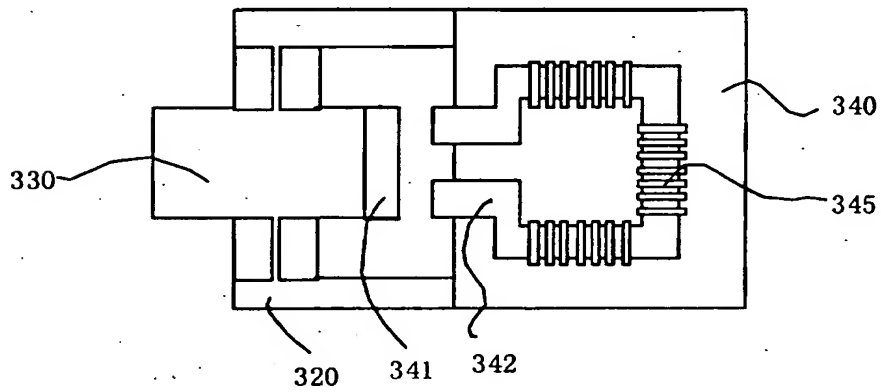
【図 1 2】



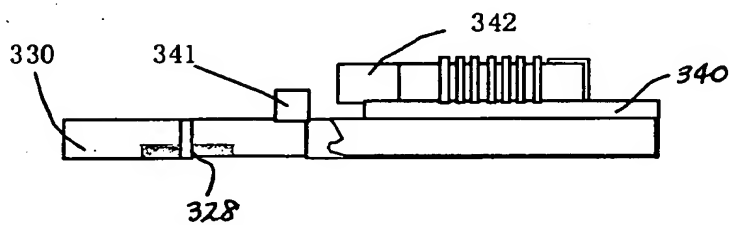
【図 1 3】



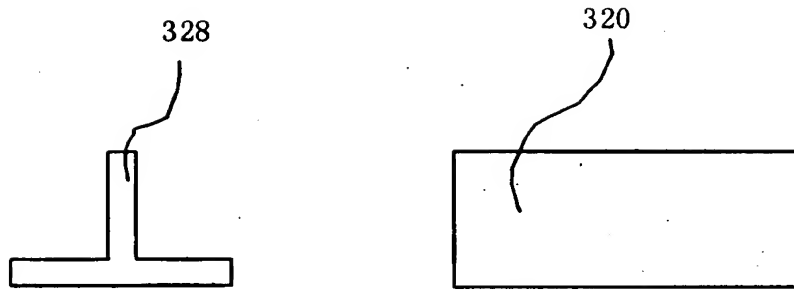
【図 1 4】



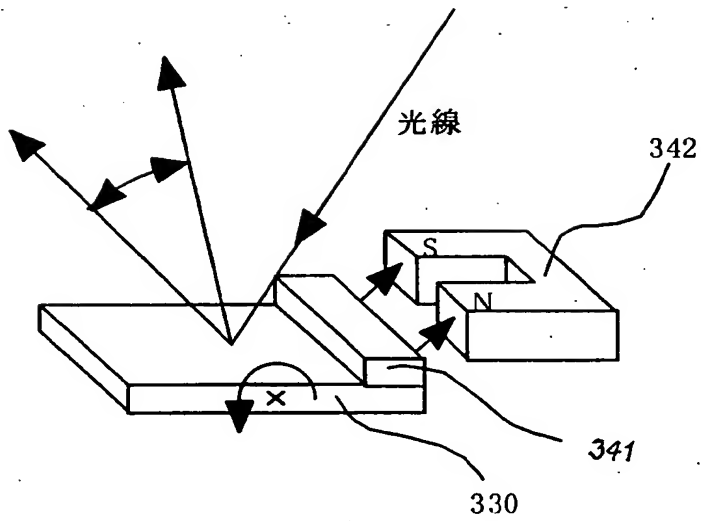
【図 1 5】



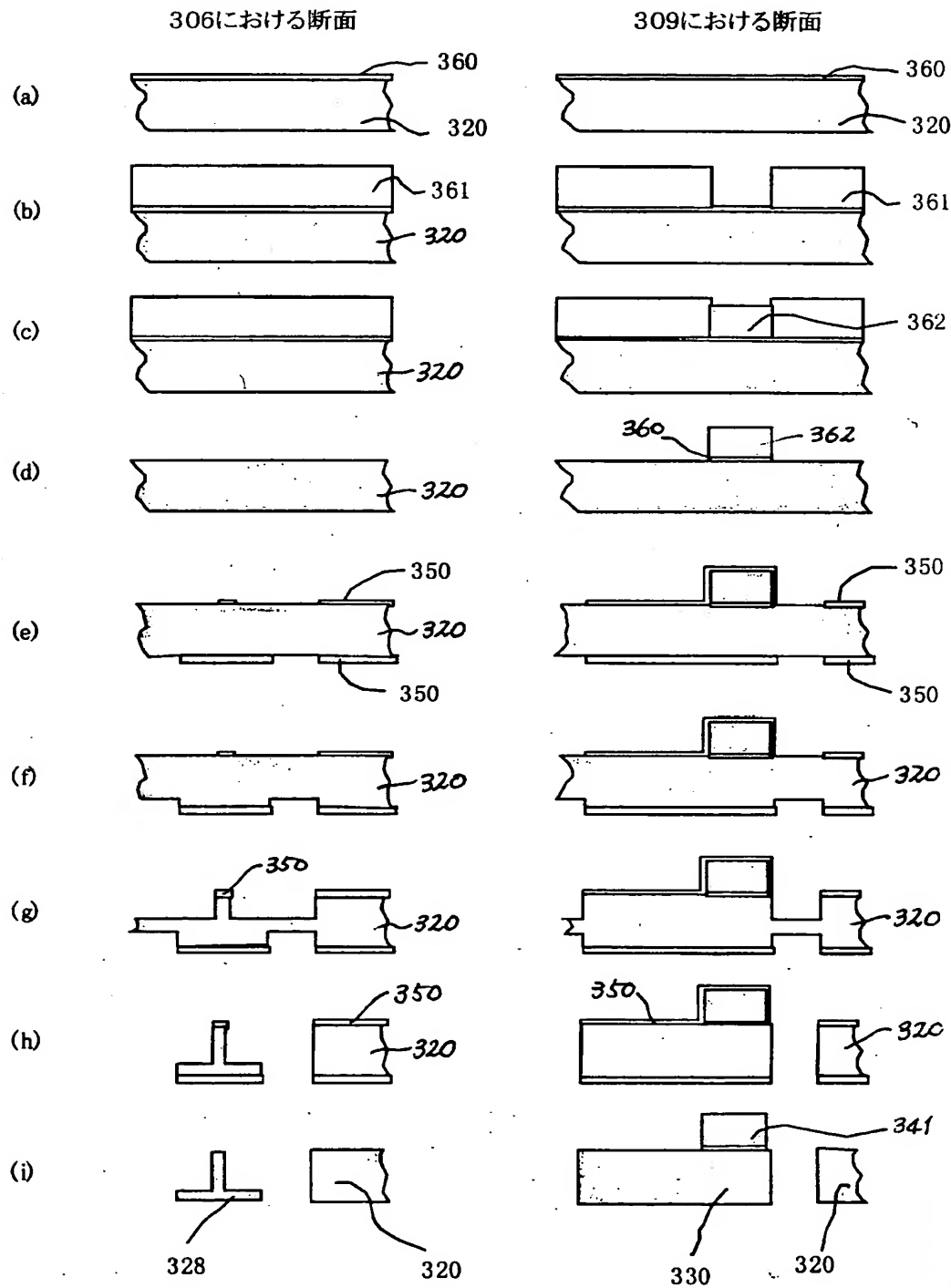
【図 1 6】



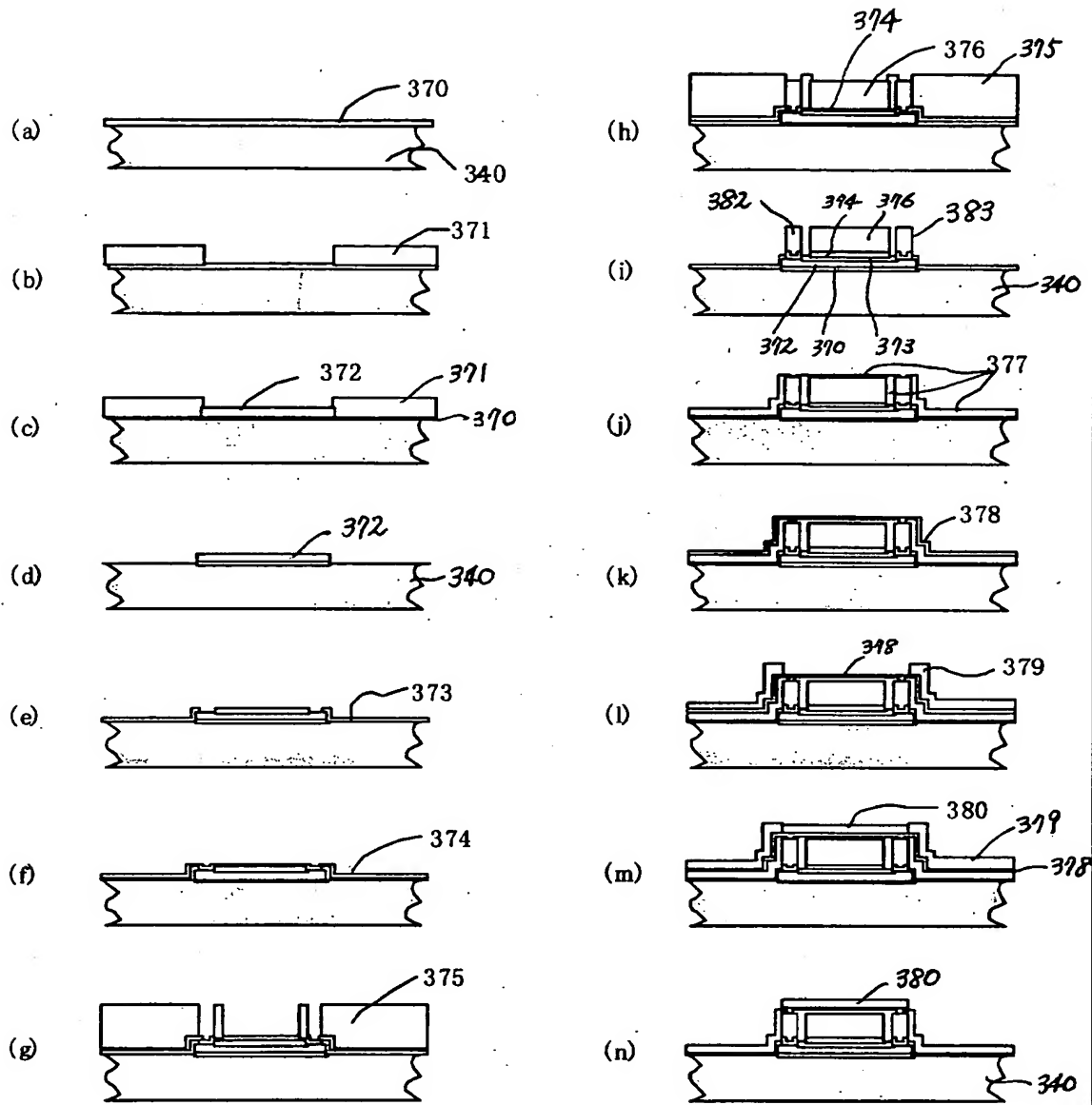
【図 1 7】



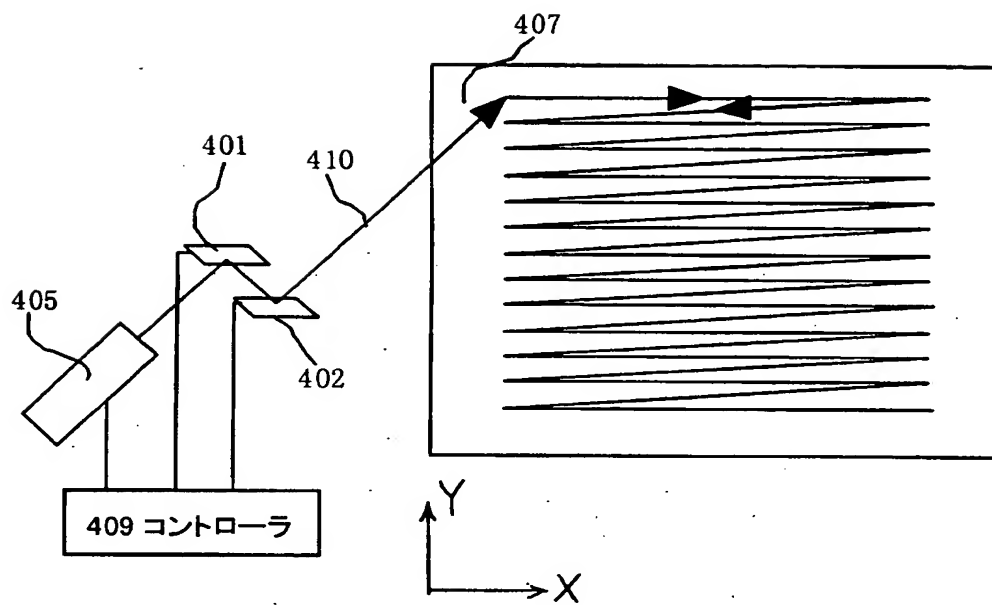
【図 1 8】



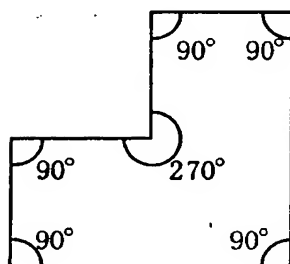
【図 19】



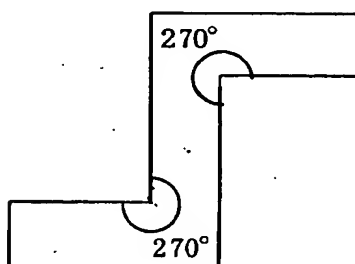
【図 2 0】



【図 2 1】

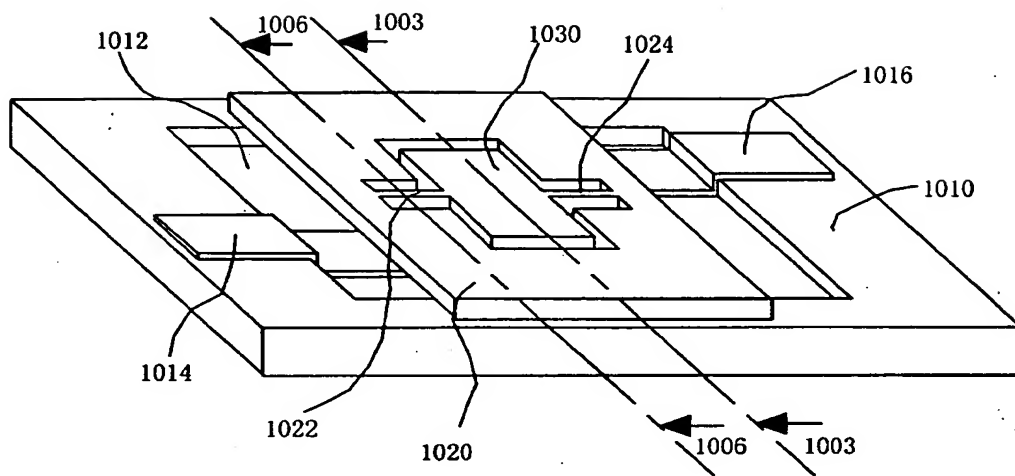


(a)

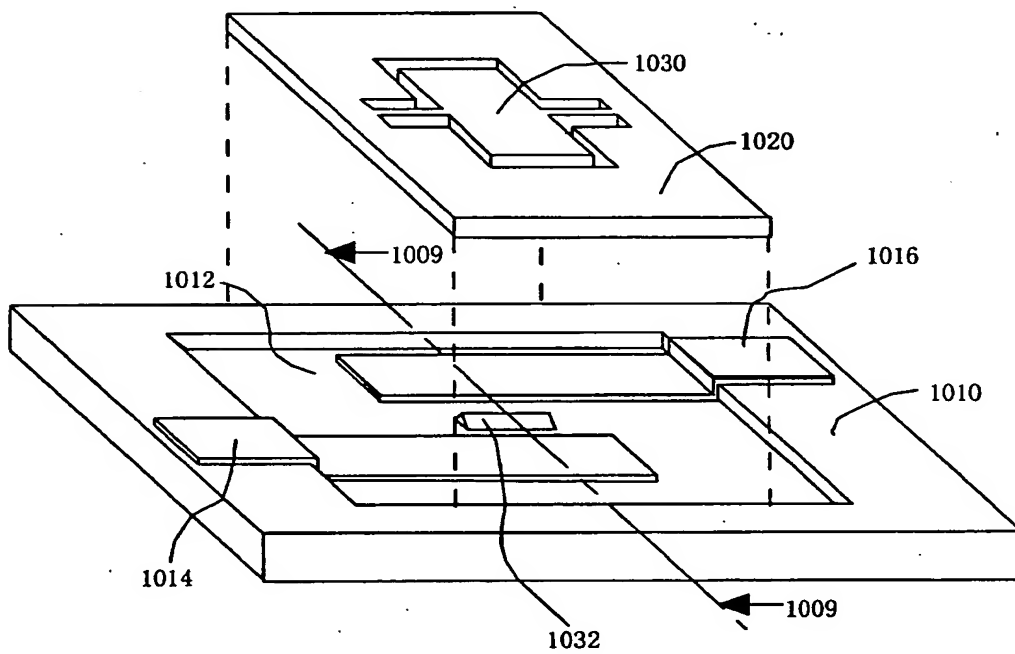


(b)

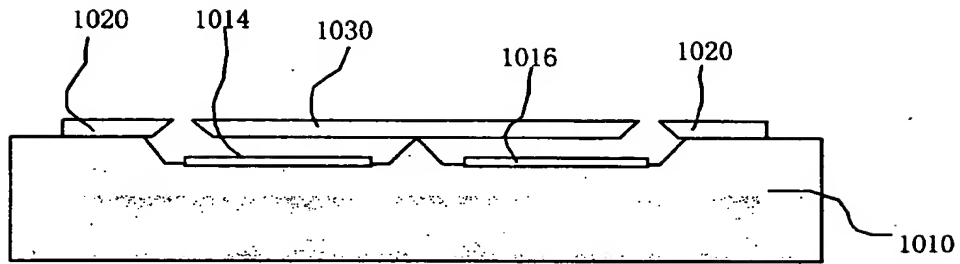
【図 2 2】



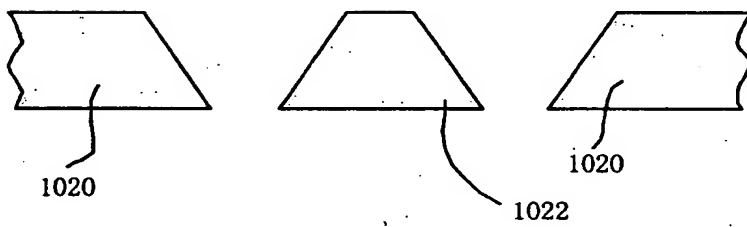
【図 2 3】



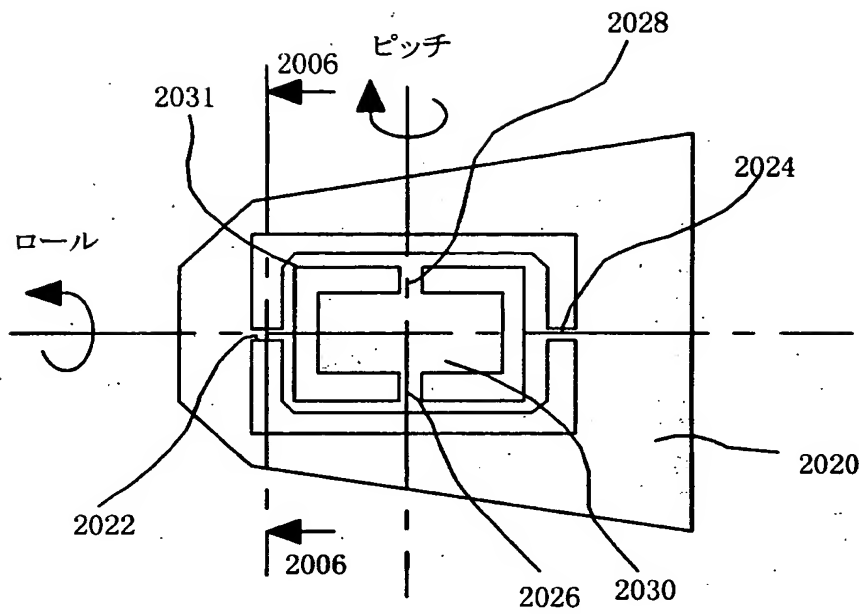
【図 2 4】



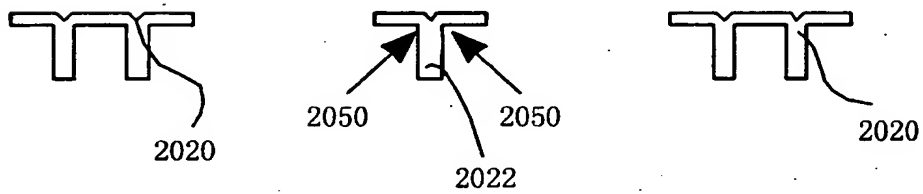
【図 2 5】



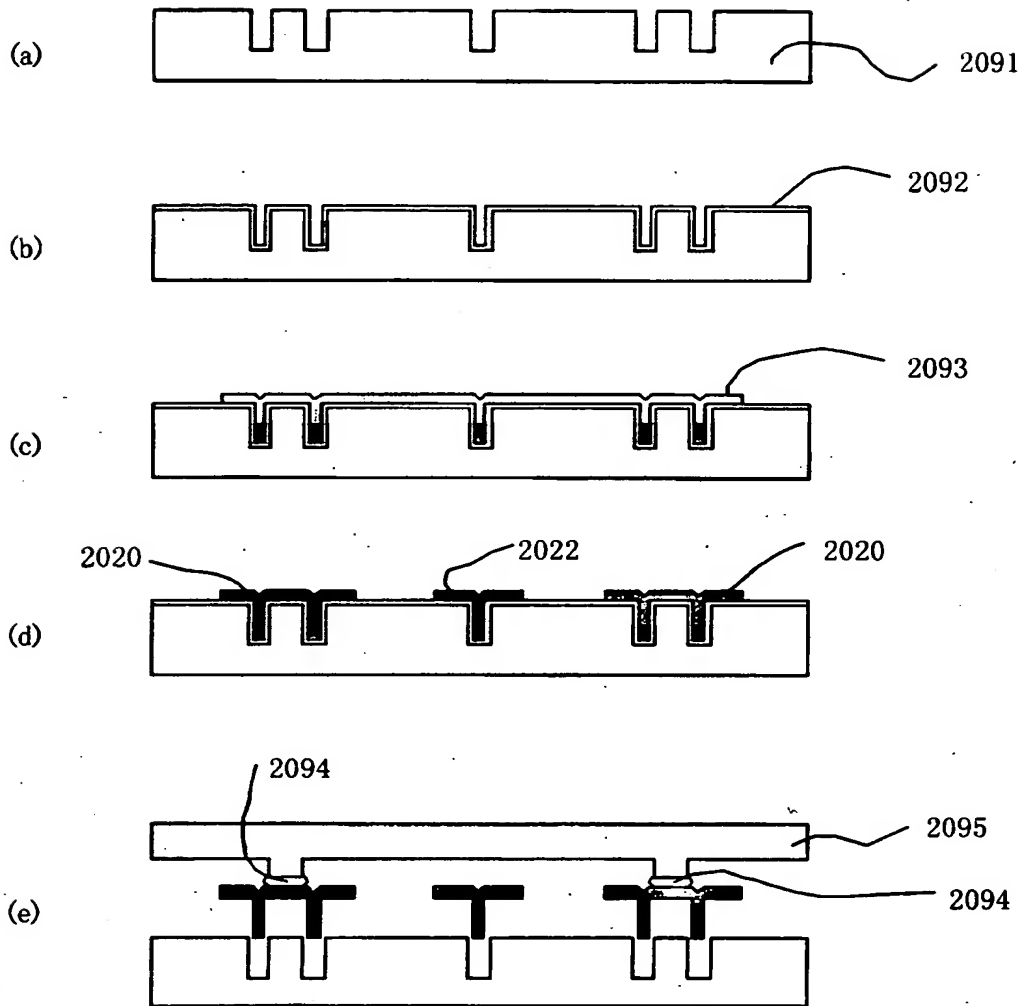
【図 2 6】



【図 2 7】



【図 2 8】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 比較的ねじれやすく、ねじれの軸に角度を成す方向に対して撓みにくいトーションバーで揺動自由に支持された揺動体を有し、機械的なQ値の高い構造を有するマイクロ構造体である。

【解決手段】 マイクロ構造体は、基板110と、少なくとも一つの揺動体130を有し、揺動体130が1本以上のトーションバー128、129によって基板110に対して弾性的に揺動自由に支持されている。トーションバー128、129は、横断面形状が略多角形であり、その少なくとも一つの内角が180度よりも大きく、また、その材質が単結晶材料から成る。

【選択図】 図1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000001007]

1. 変更年月日	1990年 8月30日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都大田区下丸子3丁目30番2号
氏 名	キヤノン株式会社